

## 다중 CSI 와 Voltage Clamping 에 관한 연구

정연백, 한경희, 황탁훈, 김현우  
명지대학교

## A Study on the Voltage Clamping of the multi-CSI

Y.T.CHUNG, K.H.HAN, L.H.HWANG, H.W.KIM<sup>o</sup>  
MYONG-JI UNIVERSITY

## 1. 서론

대용량 유도전동기를 가변속 구동하기 위하여 최근에 많이 이용되고 있는 CSI(Current Source Inverter)는 동작시 발생되는 다수의 고조파와 전류(電流)가 발생되는 전압 Spike가 커다란 문제점으로 대두되어 왔다.

따라서 본 논문은 전류(電流)가 발생되는 전압스마이크를 최대한 억제시킬 수 있는 Voltage Clamping 회로를 도입하여 CSI 시스템에 적용하였으며, 또한 기존 CSI에 억제팀 다이오드와 디액터스를 삽입하여 CSI의 겹침증에 하나인 출력전류에 포함되는 다수의 고조파를 다중화하여 제거하므로서 양호한 출력전압 및 전류파형을 얻고자 하였다.

종래의 다중 HFCSI는 다수의 고조파는 충분히 제거할 수 있는 방법이나 다중화 할 때 발생되는 전류(電流)가 전압스마이크는 다중화한 것의 배수 만큼 더 발생되기 때문에 대용량 유도전동기 구동시 전압스마이크로 인한 전력손실이 크고 반도체 소자의 전동기속에 나쁜 영향을 준다.

이에 본 논문은 다중 HFCSI의 장점인 고조파의 충분한 억제를 최대한 보장하고 온전시 다중화한 배수 만큼 더 발생되는 전압스마이크를 최대한 억제시킬 수 있도록 하였고, 억제되는 전력만큼을 다시 전원쪽으로 회생시킴으로서 스마이크에 의한 전력손실을 최대한 줄일 수 있도록 하였다.

## 2. 주회로 및 동작원리

그림 1은 본 논문의 주회로장치로서 12상 다중 HFCSI에 VCC(Voltage clamping Circuit)를 도입하여 구성한 본 시스템의 주회로 블록다이어그램이다.

시스템 구성은 사이티스 퍼와 트랜지스터, 정류회로와 혼デン서, 다이오드 등으로 구성되어 있는 VCC와 12상 다중 HFCSI로 구성되어 있다.

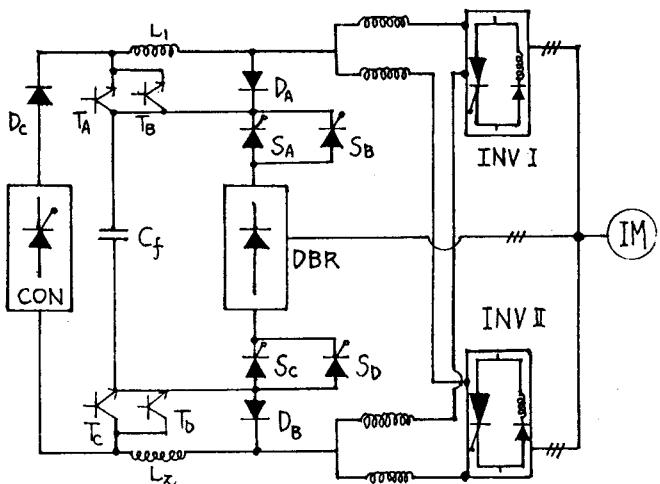


그림 1. 주회로 블록다이어그램  
VCC 회로 내의 사이티스 퍼와 트랜지스터는 게이트 신호가 다중 HFCSI에 인가되는 게이트신호와 동기가 되도록 설계가 되었고 각 인버터에서 전류(電流)가 발생하게 될 때 각각의 전압스마이크를 VCC를 동작시켜 전압스마이크를 클립핑할 수 있도록 게이트신호를 조합하였다.

그림 1에서 각 인버터의 전압스마이크를 억제하기 위하여 동작되는 혼덴서의 층, 방전은 트랜지스터 TA, TB 와 TC, TD 그리고 사이티스 퍼 SA, SB, SC, SD는 인버터에서 전류(電流)가 발생하면 사이티스 퍼가 동작하고 전류(電流)가 끊나면서 트랜지스터가 동작하게 된다. 이때 그 동작 주파수가 다중화한 배수 만큼 더 높아지기 때문에 반도체 소자의 스위칭 시간을 고려하여 2개의 신호로 분리하여 스위칭주파수를 1/2로 줄일 수 있도록 게이트신호를 설계하였다.

주회로에서 INV I에서 전류(電流)가 발생함과 동시에

다음 순간에는 INVⅡ에서 전류(電流)가 발생하면서 VCC의 사이리스터  $S_A$ 와  $S_B$ ,  $S_C$ 와  $S_D$ 가 고대로 동작하게 되어 흔데서  $C_f$ 에 충전을 시하게 된다.

이때 사이리스터  $S_A$ 와  $S_C$ ,  $S_B$ 와  $S_D$ 는 같은 게이트신호로 인가되어 뒤에 동시에 펀-온은 펀-오프되어며 흔데서에 충전된 전압은 이미 다이오드  $D_A$ ,  $D_B$ 를 통하여 전원전압으로 충전되어 있으므로 각 인버터의 전압스위치는 그 초자된 값이 3상 정류회로인 DBR을 통하여 흔데서  $C_f$ 에서 충방전된다.

$C_f$ 에 방전은 트랜지스터  $T_b$ ,  $T_c$ ,  $T_d$ 가 고대로 펀-온함으로서 방전을 하게 된다. 방전전류는 빠워터를 통하여 각 인버터에 다시 회생될로서 이때 흔데서는 전원전압보다 높은 하나의 전원으로 생각할 수 있다.

흔데서  $S_D$ 가 방전한 직후 트랜지스터  $T_a$ ,  $T_b$ ,  $T_c$ ,  $T_d$ 에 인가되는 모든 신호는 펀-온 오프상태가되고 동시에 각 인버터에서는 또 하나의 전류(電流)가 시작된다. 그 때 흔데서는 방전직후 다이오드  $D_A$ ,  $D_B$ 를 통하여 다시 전원 전압으로 재충전된다.

VDC 내의 사이리스터  $S_A$ ,  $S_B$ ,  $S_C$ ,  $S_D$ 와 트랜지스터  $T_a$ ,  $T_b$ ,  $T_c$ ,  $T_d$ 는 인버터 I, II에 인가되는 게이트신호와 상상차에 대응하여 계속 고대로 두 인버터의 전류(電流) 전압스위치를 DBR을 통하여 VCC에 연결시켜 준다.

따라서 흔데서는 항상 같은 균형을 유지하게 되고 충전된 값으로 인하여 각 인버터의 전압스위치는 전원 전압값으로 충전된다.

6상 HFCSI의 경우와 마찬가지로 12상 다중 HFCSI 운전시에도 전압스위치를 제거하는 물론 보다 양호한 출력전압, 전류파형을 얻을 수 있고 소자에 대한 전압스트레스를 감소시킬 수 있으며 또한 전동기 작업의 원인인 고조파도 제거함으로서 전체시스템의 효율도 증가시킬 수 있다.

그림 2는 주회로를 동작시킬기 위한 게이팅보드를 나타낸 것이다.

전압/주파수변환기인 9400소자를 이용하여 펄스수를 72등분(각 5%분할)하고 조합 각 인버터의 게이트 점호각을 90, 150도로 하였다.

### 3. 실험 결과 및 고찰

그림 1과 같이 본 시스템을 구성하여 유도전동기를 구동하였을 때 6상 HFCSI와 12상 HFCSI를 비교하여 출력전압 및 전류파형, 흔데서 충전전압파형을 그림 3, 그림 4, 그림 5에 나마낼 수 있고 다중 12상을 탭핑회로첨가식과 첨가하지 않았을 경우의 출력파형을 그림 6, 그림 7에 나마낼 수 있다.

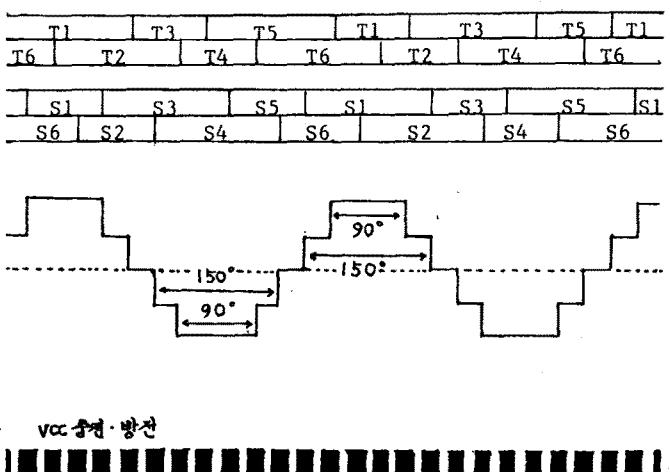
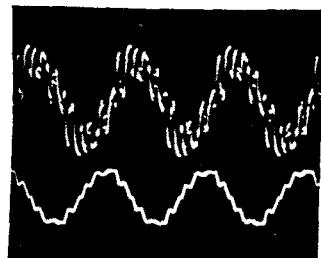
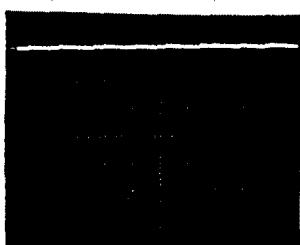
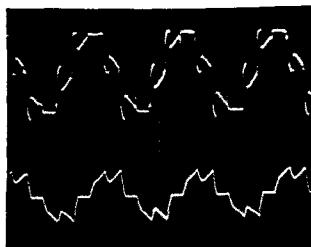
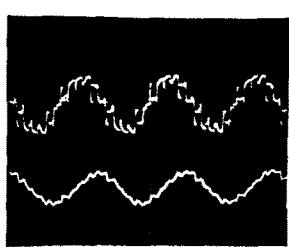


그림 2. 게이팅 모드

그림 3. 6상 HFCSI의 전압전류파형  
(VCC 첨가식)그림 4. 12상 HFCSI의 전압전류파형  
(VCC 첨가식)그림 5. 12상운전시 흔데서 전압파형( $C_f$ )  
100V/dIV, 2ms/dIV그림 6. 6상전압전류파형  
(VCC 첨가 없을 시)그림 7. 12상전압전류파형  
(VCC 첨가없을 시)  
100V/dIV, 2A/dIV, 2ms/dIV  
200V/dIV, 1A/dIV, 2ms/dIV

## 4. 결론

12상 다중 HFCSI 를 이용하여 유도전동기를 구동 하였을 때 다음 각 같은 결론을 얻을 수 있다.

- (1) 양호한 출력전압 및 전류파형을 얻을 수 있다.
- (2) 대용량 유도기의 전류설정이용이 가능하다.
- (3)  $C_f$  의 충전 전압은 인버터에서 전류(脈流) 시에 전압스케이크를 전원측으로 회생할 수 있다.
- (4) 12상 이상의 다중 HFCSI 운전시에도 케이트신호의 조합만으로도 VCC 용용이 가능하다.
- (5) VCC 의 첨가로 반도체소자의 스트리스를 감소시킬 수 있다.

## \* 참고문헌\*

- (1) RASAPPA.G PALANIAPPAN "Voltage Clamping Circuit for CSI/IM Drives" IEEE, TRANS.IND.APPL.Vol IA-21. No.2,MAR/APR, pp429-447, 1985.
- (2) RASAPPA.G PALANIAPPAN " High Frequency Current Source Inverter" IEEE.TRAN. Vol.IA-16,pp431-437, 1980.
- (3) Y.T.CHUNG,K.H.HAN,L.H.HWANG,J.H.PACK "A Study on the multi HFCSI Drives" KIEE.ELEC.Mach.21-1-5,1985.6.
- (4) YOKUKADA. HINODESUO "The Application of Induction Motor drives by the multiple Current Inverter" OHM Ltd,pp.40-43, 1978.